

ГТ612А-4

ТРАНЗИСТОРЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ СВЧ MEDIUM-POWER MICROWAVE TRANSISTORS

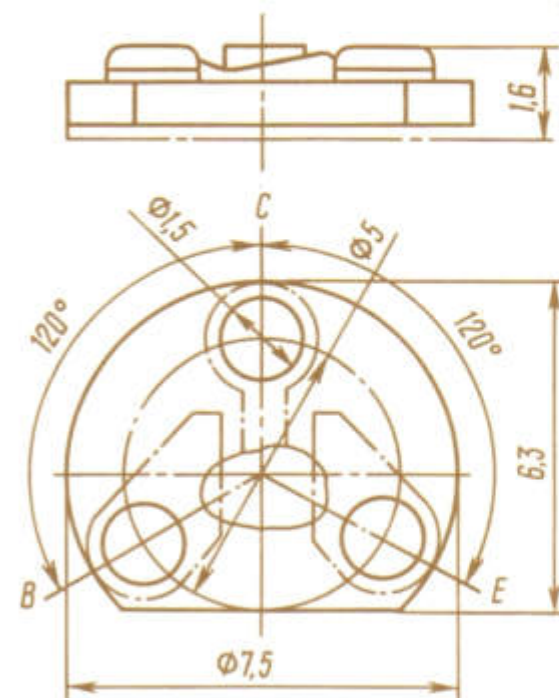
Транзисторы ГТ612А-4 предназначены для работы в неремонтируемых гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках, имеющих герметичную защиту от действий солнечного света, влаги, соляного тумана, плесневых грибков, повышенного и пониженного атмосферного давления, используемых в устройствах широкого применения.

Ge-n-p-n-P

The ГТ612А-4 transistors are designed for use in non-repairable hybrid circuits, micromodules, assemblies and subassemblies which are hermetically protected against the effects of sunlight, humidity, salt spray, mould fungi, high and low atmospheric pressure. The devices are intended for use in a wide range of applications.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДАННЫЕ $t_{case} = -55...+70^{\circ}C$
MAXIMUM RATINGS

I_{Cmax}, mA	120
U_{CBOmax}, V	12
U_{EBOmax}, V	0,2



$P_{Cmax}, (t_{case} \leq 25^{\circ}C), mW$	360
$t_{jmax}, ^{\circ}C$	100

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	ГТ612А-4	Режимы Conditions
1	2	3
$I_{CBO}, \mu A$	≤ 10	$U_{CB} = 12 V$
$I_{EBO}, \mu A$	≤ 10	$U_{EB} = 0,2 V$
$ h_{21e} $	≥ 5	$U_{CB} = 5 V$ $I_E = 50 mA$ $f = 300 MHz$

1	2	3
$P_{out (av)}, W$	0,2	$U_{CB} = 8 V$ $I_C = 90 mA$
C_c, pF	$\leq 3,5$	$U_{CB} = 5 V$ $f = 10 MHz$
τ_c, ps	≤ 7	$U_{CB} = 5 V$ $I_E = 50 mA$ $f = 30 MHz$

